12-14 章 电磁学

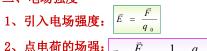
基本内容

- 1、电荷、库仑定律; 2、电场、电场强度(场强叠 加原理、电场强度的计算)。
- 3、电通量、静电场中的高斯定理及应用。
- 4、静电场的环路定理、电势差与电势。
- 5、电势叠加原理; 6、电势的计算:
- 7、等势面, 电场强度与电势的微分关系。
- 8、导体的静电平衡及其条件;
- 9、静电平衡下导体上电荷的分布;
- 10、有导体存在的静电场的计算。
- 11、电容; 12、电容器串联和并联;
- 13、电容器的储能、电场的能量。

- 14、电流强度、电流密度、电流的连续性方程、稳恒 电流; 15、电动势。16、磁场、磁感应强度; 17、磁 通量; 18、磁场中的高斯定理; 19、毕奥-萨伐尔定律。 20、毕奥-萨伐尔定律的应用; 21、安培环路定理及其 应用。22、磁场对载流导线和载流线圈的作用; 23、 安培定律。
- 24、法拉弟电磁感应定律; 25、楞次定律。
- 26、动生电动势; 27、感生电动势。
- 28、自感应、互感应: 29、自感磁能、磁场能量。

I.静电场小结

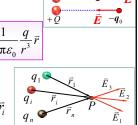
$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\,\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12} = -\vec{F}_{21}$$



2、点电荷的场强: $\bar{E} = \frac{\bar{F}}{q_0} = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{q}{r^3} \bar{r}$



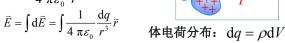
$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_{i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q_{i}}{r_{i}^{3}}$$

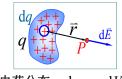


电荷 q_1 对 q_2 的作用力 F_{21}

2) 电荷连续分布的带电体

$$d\vec{E} = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{dq}{r^3} \vec{r} \qquad \Longrightarrow \qquad$$





面电荷分布: $dq = \sigma ds$ 线电荷分布: $dq = \lambda dl$

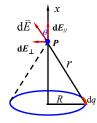
计算步骤: ①建坐标; ②取电荷元 dq;

- ③确定 dĒ 的方向和大小:
- ④将 dĒ 投影到坐标轴上;
- ⑤统一变量,对分量积分;
- ⑥合成确定 \bar{E} 大小和方向。

例2 均匀带电圆环轴线上一点的场强。设圆环带电 量为q,半径为R。

解: 在圆环上任选 dq, 引矢径 r 至场点, 由对称性可 知, p 点场强只有 x 分量。

$$E = \int_{q} dE_{x} = \int dE \cdot \cos \theta$$
$$= \int_{L} \frac{dq}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} \cos \theta$$
$$= \frac{\cos \theta}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} \int_{L} dq$$



$$E = \frac{\cos\theta \cdot q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{qx}{4\pi\varepsilon_0 (R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

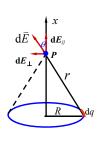
讨论

(1) 当 x = 0时,即在圆环中心处

$$E=0$$

皆 $x>>R$,则 $E=rac{1}{4\pi arepsilon_c}rac{q}{x^2}$

可以把带电圆环视为一个点电荷。



解 带电圆盘可看成许多同心的圆环组成,取一半径为 r, 宽度为dr 的细圆环带电量:

$$dq = \sigma 2\pi r \cdot dr \quad dE = \frac{dqx}{4\pi \varepsilon_0 (r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \quad \vec{E} \quad x$$

$$E_x(p) = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left[1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{\frac{1}{2}}} \right]$$

$$\int_{0}^{R} \frac{r dr}{(r^{2} + x^{2})^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{2} \int_{0}^{R} \frac{d(r^{2} + x^{2})}{(r^{2} + x^{2})^{\frac{3}{2}}} \int x^{\mu} dx = \frac{x^{\mu + 1}}{\mu + 1} + c$$

$$= -\frac{1}{(r^{2} + x^{2})^{\frac{1}{2}}} \Big|_{0}^{R}$$

$$= \frac{1}{x} - \frac{1}{(R^{2} + x^{2})^{\frac{1}{2}}}$$

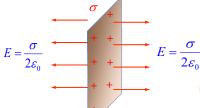
$$E_{x}(p) = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_{0}} \int_{0}^{R} \frac{r dr}{(r^{2} + x^{2})^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_{0}} \left[1 - \frac{x}{(R^{2} + x^{2})^{\frac{1}{2}}} \right]$$



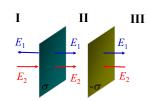
$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} [1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{1/2}}]$$

(1)当R >> x,可视为无限大平板。



电场强度垂直 带电平面

(2) $E_{1} = E_{1} - E_{2} = 0$ $E_{II} = E_{1} + E_{2} = \frac{\sigma}{\varepsilon_{0}}$ $E_{III} = E_{1} - E_{2} = 0$



(3) 补偿法 (空心圆盘在P点处的场强)

$$\vec{E} = \vec{E}_{R_2} - \vec{E}_{R_1} \qquad E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} [1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{1/2}}]$$

$$= \frac{x\sigma}{2\varepsilon_0} [\frac{1}{(R_1^2 + x^2)^{1/2}} - \frac{1}{(R_2^2 + x^2)^{1/2}}]\vec{i}$$

几种典型带电体的电场分布:

1) 有限长带电直线

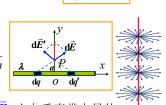
$$E_{x} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_{0}a}(\sin\theta_{2} - \sin\theta_{1})$$

$$E_{y} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_{0}a}(\cos\theta_{1} - \cos\theta_{2})$$

2) 无限长带电直线

$$\begin{array}{ccc}
\theta_1 \to 0 & \theta_2 \to \pi \\
E_x = 0 & E = E_y = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}
\end{array}$$





3) 无限大带电平面

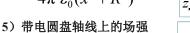






4) 带电圆环轴线上的场强

$$E = \frac{qx}{4\pi \ \varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$



$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} [1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{1/2}}]$$



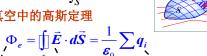
三、真空中的高斯定理

(1) 电场线

静电场电场线特性

①始于正电荷, 止于负电荷(或来自无穷远, 去向无穷 远); ②电场线不相交; ③静电场电场线不闭合.

- (2) 电通量 $\Phi_{\rm e} = \int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$
- (3) 真空中的高斯定理



通过封闭曲面的 电通量由面内的 电荷决定

E 是面元dS所在 处的场强,由全 部电荷(面内外电

封闭面内电 荷代数和

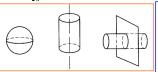
15

17

荷)共同产生的

(4) 利用高斯定理求 \bar{E} 步骤为:

- ①由电荷分布的对称性分析电场分布的对称性.
- ②在对称性分析的基础上选取高斯面. 目的是使



选取高斯面的技巧:

- 使场强处处与面法线方向垂直, 以致该面上的电通量为零。
- 使场强处处与面法线方向平行, 且面上场强为恒量。这种面上的 电通量简单地为 ES 。
- (球对称、轴对称、面对称)
- ③由高斯定理 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\rm p}$ 求出电场的大小, 并说明其方向.

例4 已知球体半径为R, 带电量为a (电荷体密度为 ρ)。

求:均匀带电球体的电场强度分布。

解: 球外 $r \geq R$

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E4\pi r^{2} = \frac{q}{\varepsilon_{0}}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q}{r^{2}} \vec{r}^{0}$$

$$= \frac{\rho}{3\varepsilon_{0}} \frac{R^{3}}{r^{2}} \vec{r}^{0}$$

$$\rho = \frac{q}{4\pi R^{3}} = \frac{3q}{4\pi R^{3}}$$

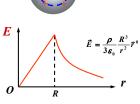
球内 r < R

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^{2}$$

$$=\frac{1}{\varepsilon_0}q'=\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{4}{3}\pi r^3\rho$$

$$E = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}r$$

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}$$



电场分布曲线

16

例5 "无限大"均匀带电平面上电荷面密度为 σ 。 求:电场强度分布。

解:电场强度分布具有面对称性。

空间各点电场强度分布具有面对称性,即离带电平面等距离处各点电场强度E的大小相等,方向与带电平面垂直。

选取一个圆柱形高斯面

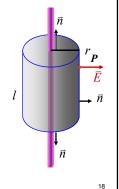


M6 无限长均匀带电直线的电荷线密度为 $+\lambda$ 。 求: 距直线 r 处一点P 的电场强度。

分析: 电场分布具有轴对称性。

距离导线 r 处一点 p 点的场强方向 一定垂直于带电直导线沿径向, 且r相同处场强大小相同。

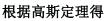
以带电直导线为轴,作一个通过P点, 高为l的圆筒形封闭面为高斯面S, 通过S面的电通量为圆柱侧面和上下 底面三部分的通量和。



解:电场分布具有轴对称性。

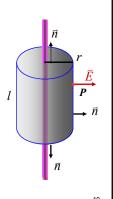
过P点作高斯面

$$\begin{split} & \boldsymbol{\mathcal{\Phi}}_{e} = \oint_{S} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ & = \int_{\mathfrak{M}} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} + \int_{\text{LM}} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} + \int_{\text{FM}} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ & = \int_{\mathfrak{M}} E \mathrm{d}S = E \int_{\mathfrak{M}} \mathrm{d}S = E \cdot 2\pi r \cdot l \end{split}$$



$$E \cdot 2\pi r \cdot l = \frac{1}{\varepsilon_0} \lambda l$$





四、静电场的环路定理

五、电势能、电势

(1) 电势能
$$A_{ab} = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(W_b - W_a) = W_a - W_b$$

(2) 电势

$$u_a = \frac{W_a}{q_a} = \frac{A_{a''0''}}{q_a}$$
 $u_a = \int_a^{"0''} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$$u = \int_{0}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

(3) 电势差
$$U_{ab} = u_a - u_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

静电场力的功
$$A_{ab} = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 U_{ab} = q_0 (u_a - u_b)$$

(4) 电势的计算 $\diamond U_{\infty} = 0$

①点电荷的电势

$$u_P = \frac{q}{4 \pi \varepsilon_0 r}$$



②点电系的电势

$$u_P = \sum_i u_{Pi} = \sum_i \frac{q_i}{4\pi \varepsilon_0 r_i}$$



③电荷连续分布

$$u_P = \int \frac{\mathrm{d}q}{4 \, \pi \varepsilon_0 r}$$



(5) 电势与电场强度的微分关系

$$\vec{E} = -(\frac{\partial u}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z}\vec{k}) = -\operatorname{grad}(u) = -\nabla u$$

$$E_x = -\frac{\partial u}{\partial x}$$
 $E_y = -\frac{\partial u}{\partial y}$ $E_z = -\frac{\partial u}{\partial z}$

讨论

求电势的方法

①已知场源电荷的分布,利用点电荷电场的电势 公式及电势叠加原理进行电势的求解,如

利用
$$u_p = \int \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$
 或 $u_p = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$

(利用了点电荷电势公式,这一结果已选无限远处 为电势零点,即使用此公式的前提条件为有限大带 电体且选无限远处为电势零点.)

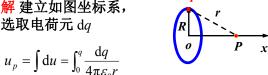
②已知场强的分布,利用电势与场强的积分关系, 即电势的定义式计算电势。

$$u_p = \int_p^{"0"} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

例1均匀带电圆环半径为R,电量q。

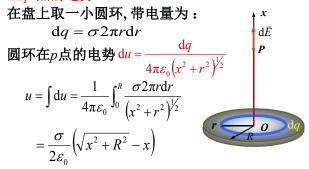
求 圆环轴线上一点的电势。

解 建立如图坐标系, 选取电荷元 da



$$=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$$

利用以上结果,可以计算均匀带电圆盘轴线上p点的电势。



$$u = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{x^2 + R^2} - x \right)$$

当 x>>R 时

$$\sqrt{x^2 + R^2} \approx x + \frac{R^2}{2x}$$
$$u \approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{R^2}{2x} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x}$$

在离圆盘很远处,可以把圆盘看成一个点电荷。

26

<mark>例3</mark> 求电荷线密度为λ的无限长带电直线空间中的电势分布。

取a点为电势零点,a点距离带电直线为xa

$$u_{p} = \int_{(P)}^{(a)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{x_{p}}^{x_{a}} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_{0}x} dx$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_{0}} (\ln x_{a} - \ln x_{p})$$

$$x = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_{0}} (\ln x_{a} - \ln x_{p})$$

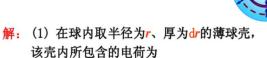
取 $x_a = 1$, $\ln x_a = 0$ (场中任意一点P 的 电势表达式最简捷)

电势表达式最简捷)
$$u_{\rm P} = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln x$$
 离带电直线的距离

77

一半径为 \mathbb{R} 的带电球体,球体内电荷体密度分布为 $\rho = (qr)/(mr^*)$ 求: (1)带电球体的总电量; (2)球体内外各点的电场强度;

(3) 球体内外各点的电势.



$$dq = \rho dV = \frac{qr}{\pi R^4} 4\pi r^2 dr = \frac{4qr^3}{R^4} dr$$

28

 $dq = \rho dV = \frac{qr}{\pi R^4} 4\pi r^2 dr = \frac{4qr^3}{R^4} dr$

则球体所带的总电荷为

$$Q = \int_{V} \rho dV = \frac{4q}{R^4} \int_{0}^{R} r^3 dr = q$$

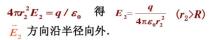


(2) 在球内作一半径为广门的高斯球面,按高斯定理有

$$4\pi r_1^2 E_1 = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^{r_1} \frac{qr}{\pi R^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{qr_1^4}{\varepsilon_0 R^4}$$

得
$$E_1 = \frac{qr_1^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}$$
 $(r_1 \leq R)$ \bar{E}_1 方向沿半径向外

在球体外作半径为r₂的高斯球面,按高斯定理有



(3) 球内电势



球外电势

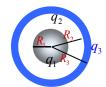
$$U_2 = \int_{r_2}^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = \int_{r_2}^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_1 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2} \qquad (r_2 > R)$$

30

六、静电场中的导体

- 1. 静电平衡条件: 导体内部场强处处为零。 推论: 1) 整个导体是等势体,表面是等势面。
 - 2) 导体表面上的场强垂直与该点表面。
- 2. 在静电平衡条件下,导体上的电荷分布:
- 1) 实心导体: (不论导体是否带电,不论导体是否在外电场中) 导体内部没有净电荷,电荷只能分布在导体表面上。
- 2) 空腔导体: 腔内无电荷时 -- 电荷只分布在外表面上; 腔内有电荷时 -- 导体内表面电荷与腔内电荷 代数和为零。
- 3)导体表面电荷密度与场强关系: $\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ \vec{n}

求: 此系统的电荷、电场分布 和电势分布以及 球与 球壳间 的电势差; 如果用导线将球壳 和球连接, 又如何?



解:电荷分布:

设球壳内、外表面电量为 q_2 、 q_3 。 球体外表面: q_1 球壳内表面: $q_2 = -q_1$

32

球壳外表面: $q_3 = q - q_2 = q + q_1$

电场分布: 作<u>高斯面 $S_1 \times S_2 \times S_3$ </u>和 S_4

由高斯定理 $\oint_{s} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \sum \frac{q}{\varepsilon_{0}}$ 得 $E_{1} = 0 \qquad r < R_{1}$

得 $E_1 = 0$ $r < R_1$ $E_2 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_o r^2} R_1 < r < R_2$

 $E_3 = 0$ $R_2 < r < R_3$ $E_4 = \frac{q_1 + q}{4\pi\varepsilon_o r^2}$ $r > R_3$

电势分布

$$u_a = \int_a^{"0"} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

 $r < R_1$ $u_1 = \int_{r}^{R_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{R_2}^{R_3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{l} + \int_{R_3}^{\infty} \vec{E}_4 \cdot d\vec{l}$

 $R_{1} < r < R_{2}$ $= \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(\frac{q_{1}}{R_{1}} - \frac{q_{1}}{R_{2}} + \frac{q_{1} + q}{R_{3}} \right)$

 $u_2 = \int_r^{R_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{R_3}^{\infty} \vec{E}_4 \cdot d\vec{l}$

 $u_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r} - \frac{q_1}{R_2} + \frac{q_1 + q}{R_3} \right)$

 q_2 q_2 q_1 q_1 q_2 q_3 q_4

 $R_2 < r < R_3$ $u_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 + q}{R_3}$ $r > R_3$ $u_4 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 + q}{r}$

金属球与金属壳之间的电势差

$$\begin{aligned} U_{ab} &= \int_{a}^{b} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ U_{AB} &= \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{q_{1}}{4\pi\varepsilon_{o}r^{2}} dr \\ &= \frac{q_{1}}{4\pi\varepsilon_{o}} (\frac{1}{R_{2}} - \frac{1}{R_{1}}) \end{aligned}$$

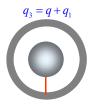


用导线将金属球和金属球壳连接,则球壳的内表面和球表面的电荷会完全中和,重新达到静电平衡,二者之间的场强和电势差均为零。

$$q_1 = 0$$
, $q_2 = 0$

球壳外表面仍保持有 q_1+q 的电量,而且均匀分 布,它外面的电场仍为:

$$E_4 = \frac{q_1 + q}{4\pi\varepsilon r^2} \qquad r > R_3$$



36

连接后、球和球壳为等势体

$$r < R_3$$
 $u_1 = u_2 = u_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 + q}{R_3}$
 $r > R_3$ $u_4 = \frac{q_1 + q}{4\pi\epsilon_0 r}$

有导体存在时静电场的计算方法

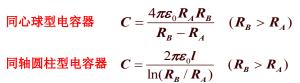
- 1. 静电平衡的条件和性质: $E_{\rm H}=0$ $U_{\rm HM}=C$
- 2. 电荷守恒定律;
- 3. 确定电荷分布, 然后求解。

七、电容

- $C = \frac{Q}{u}$ 1、孤立导体的电容
- 2、电容器的电容 $C = \frac{Q}{U_{\perp} U_{\perp}}$

几种常见的电容器的电容:

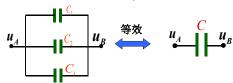




电容器的串联

电容器的并联

$$C = \sum_{i} C_{i}$$



八、静电场的能量

1、带电电容器的能量

电容器贮存的电能 $W_{\rm e} = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2$

2、静电场的能量

电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$

电场空间所存储的能量(电场总能量)

$$W_{\rm e} = \int_{V} w_{\rm e} dV = \int_{V} \frac{1}{2} \varepsilon_{0} E^{2} dV$$

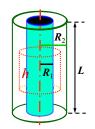
同轴圆柱形电容器的电容

已知:两筒半径分别为 R_1 (内)和 R_2 (外),筒长L,筒间为真空。

① 设所带电量为Q, 求场强

根据高斯定律,两柱面间场强为:

$$E = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 rL}$$



② 根据场强求电势差

$$U_{AB} = \int_{A}^{B} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} E \cdot dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 rL} dr = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \ln \frac{R_B}{R_A}$$

③ 计算电容
$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = 2\pi\varepsilon_0 L / \ln \frac{R_2}{R_1}$$

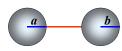
例 半径分别为a和b的两个金属球,它们的间距 比本身线度大的多,今用一细导线将两者相连 接,并给系统带上电荷O。

求: 1. 每个球上分配到的电荷:

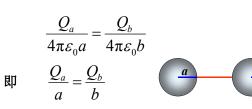
2. 按电容定义式,计算此系统的电容。

\mathbf{M}:1. $Q_a + Q_b = Q$

$$u_a = \frac{Q_a}{4\pi\varepsilon_0 a} \quad u_b = \frac{Q_b}{4\pi\varepsilon_0 b}$$



$$u_a = u_b = u$$



$$Q_a = \frac{aQ}{a+b} \qquad Q_b = \frac{bQ}{a+b}$$

2.电容
$$C = \frac{Q}{u} = \frac{Q}{u_a} = \frac{4\pi\varepsilon_0}{Q_a} = 4\pi\varepsilon_0 (a+b)$$

II. 稳恒磁场小结

一、基本概念

- 1、磁感应强度大小 $B = \frac{F_{\text{max}}}{qv}$
- 2、载流线圈磁矩

$$\vec{p}_m = IS\hat{n}$$



3、载流线圈的磁力矩

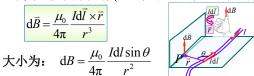
$$\overrightarrow{M} = \overrightarrow{p}_m \times \overrightarrow{B}$$

4、磁通量

$$\Phi_m = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{S} BdS \cos \theta$$

二、基本实验定律

1、毕奥—萨伐尔定律(电流元在空间产生的磁场)



方法步骤:

- ①选取合适的电流元 $Id\bar{l}$,写出电流元在P点的 $d\bar{B}$ 表达式;
- ②选择适当的坐标系,对 $d\bar{B}$ 投影,写出各分量,将矢量积分化为标量积分,统一变量给出正确的积分上下限,求出 \bar{B} 的各分量值;
- 3合成 \bar{B} 确定大小方向。

几种典型电流的磁场分布

(1) 有限长直线电流的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



(2) 无限长载流直导线的磁场

$$\begin{array}{c} \theta_1 \to 0 \\ \theta_2 \to \pi \end{array} \qquad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi \ r_0}$$

(3) 半无限长载流直导线的磁场

$$\theta_1 \to \frac{\pi}{2}$$

$$\theta_2 \to \pi$$

$$B_p = \frac{\mu_0 I}{4 \pi r_0}$$



(4) 载流导线延长线上任一点的磁场

$$\vec{B} = 0 \qquad \frac{a}{P} \qquad I$$

(5) 载流圆线圈轴线上的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

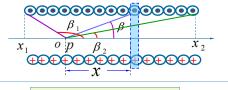
(6) 载流圆环中心的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{2 R}$$

(7) 密绕长直螺线管、密绕螺线环内部的磁场

$$B = \mu_0 nI$$

(8) 载流直螺线管的磁场



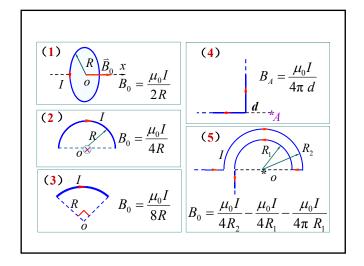
$$B = \frac{\mu_0 nI}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

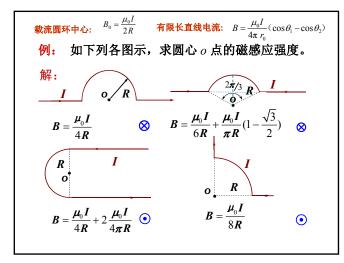
无限长的螺线管

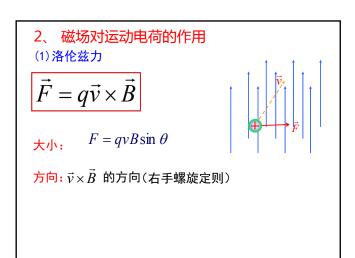
$$B = \mu_0 nI$$

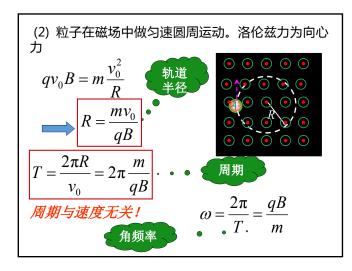
半无限长螺线管

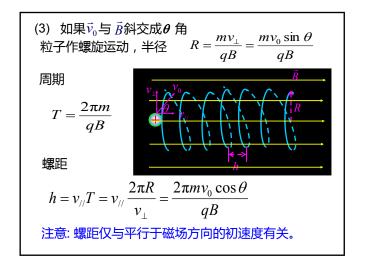
$$B = \frac{1}{2} \mu_0 nI$$

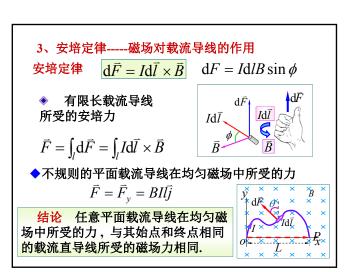


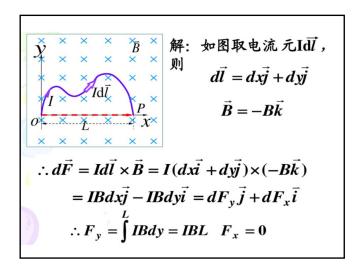


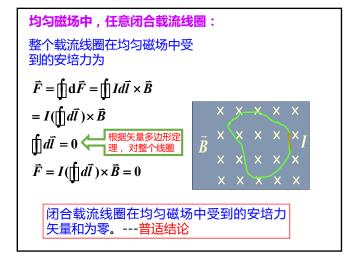


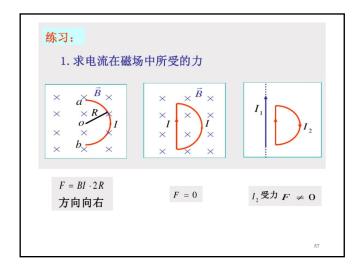


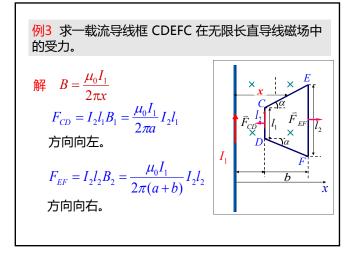


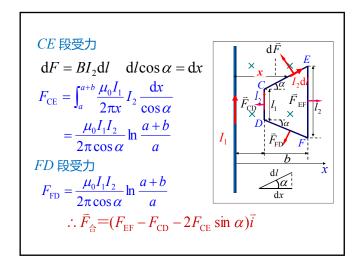


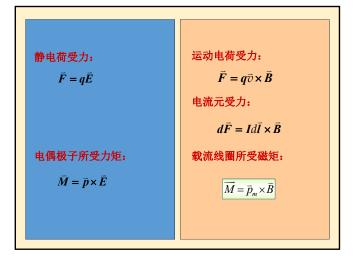












三、稳恒磁场的基本性质

- 1、磁场中的高斯定理: $\Phi_m = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
- 2、安培环路定理:

$$\iint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^{n} I_i^{\circ \circ} \circ$$

由环路内电流决定



电流 I 正负的规定:

若电流流向与积分回路构成右手螺旋,电流I取 正值; 反之, 电流 I 取负值。

$\iint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu$	$\iota_0 \sum_{i=1}^n I_i$
--	----------------------------

明确以下几点:

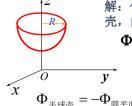
- (1) 电流正负规定: 电流方向与环路方向满足右手螺 旋定则电流I取正;反之电流I取负。
- (2) \vec{B} 是指环路上一点的磁感应强度,不是任意点的, 它是空间所有电流共同产生的。
 - (3) 安培环路定理适用于稳恒电流的磁场。
- (4) 安培环路定理说明磁场性质——磁场是非保守场, 是涡旋场。

稳恒磁场是有旋、无源场

场	磁场	电场
定义	运动 <mark>产生</mark> 磁力运动 电荷场电荷	电产生 电力 电荷
描述	磁感应强度 $B = \frac{F_{max}}{qv}$	电场强度 $\bar{E} = \frac{\bar{F}}{q} = \frac{F}{q}\hat{F}$
力	磁 点电荷 $\bar{F} = q\bar{v} \times \bar{B}$ 场 电流元 $d\bar{F} = Id\bar{l} \times \bar{B}$ 力 载流导线 $\bar{F} = \int Id\bar{l} \times \bar{B}$	电 点电荷 $\vec{F} = q\vec{E}$ 场 电荷元 $d\vec{F} = dq\vec{E}$ 力 带电体 $\vec{F} = \int dq\vec{E}$
产生	$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$	$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$
高斯 定理	$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$
环路 定理	$\oint_{I} \vec{B} \cdot d\vec{I} = \mu_0 \sum_{i} I_{i}$	$\oint_{l} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

场	磁场	电场
产生	$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$	$d\bar{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$
高斯 定理	$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$
环路 定理	$\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} \sum_{i} I_{i}$	$\oint_{l} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$
求场 的方	磁场叠 $\bar{B} = \begin{cases} \sum_{i} \bar{B}_{i} \\ \int d\bar{B} \end{cases}$	场强叠 $ar{E} = \begin{cases} \sum_i ar{E}_i \\ \int dar{E} \end{cases}$
法	安培环路定理	高斯定理
		由电势梯度
		$\vec{E} = -\nabla U$

例: 一磁场 $\vec{B} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}(T)$,则通过半径为R、 开口向z轴正方向的半球壳表面的磁通量为 $-\pi cR^2$ 。



解: 作半径为R的圆平面封住半球 壳,由磁场的高斯定理得:

$$\Phi_{m} = \Phi_{+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} + \Phi_{\underline{M}+\underline{m}}$$

$$= \oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\Phi_{+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = -\Phi_{\underline{M}+\underline{m}} = -\int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}_{\underline{M}\underline{m}} = -(\vec{B} \cdot \vec{S}_{\underline{M}\underline{m}})$$

$$= -(\vec{a}\vec{i} + \vec{b}\vec{j} + \vec{c}\vec{k}) \cdot (\pi R^{2}\vec{k}) = -\pi R^{2}c$$

利用安培环路定理求磁感应强度的关键: 根据磁 场分布的对称性,选取合适的闭合环路。

选取环路原则:

- (1) 环路要经过所求的场点:
- (2) 闭合环路的形状尽可能简单,总长度容易求;
- (3) 环路上各点 \bar{B} 大小相等,方向平行于线元 $d\bar{l}$ 。 目的是将 $\iint_{I} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{I} I$ 写成: $B = \frac{\mu_0 \sum_{I} I}{2}$ 。 或 \bar{R} 的方向与环路方向垂直,

$$\vec{B} \perp d\vec{l}$$
 , $\cos \theta = 0 \implies \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$

例2 求无限长均匀载流圆柱导体产生的磁场。

电流/均匀分布在圆柱的横截面内

已知: I、R、磁场的轴对称分布特点。

取r < R, 在垂直于轴线平面内作圆形回路 L_1 ,

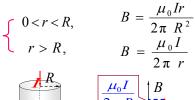
$$\begin{split} &\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_{L} dl = B2\pi r = \mu_{0} \sum_{i} I_{i} \\ &= \mu_{0} \frac{I}{\pi R^{2}} \pi r^{2} \quad B_{H} = \frac{\mu_{0}}{2\pi} \frac{Ir}{R^{2}} \end{split}$$

取 /> R在垂直于轴线平面内作圆形回路 Lo,

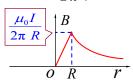
$$\oint_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 \sum_{i} I_i = \mu_0 I \qquad B_{\text{Sh}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B_{\S h} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

\bar{B} 的方向与I 成右螺旋



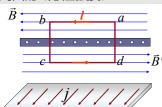




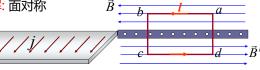
无限长均匀载流圆柱导体的磁感应强度分布图

例5 求 "无限大" 薄导体板 , 单位宽度上的恒定电 流为/, 求导体平板周围的磁感应强度。

解:面对称







$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{ab} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{bc} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{cd} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{da} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$= B \int_{a}^{b} dl + B \int_{c}^{d} dl = 2Bab = \mu_{0}abj \qquad B = \mu_{0}j/2$$

无限大平板:

面电荷密度σ:

单位宽度上的恒定电流为扩

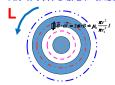
$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

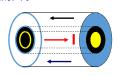
$$B = \mu_0 j / 2$$

例: 电缆由导体圆柱和一同轴的导体圆筒构成, 使用时电流 从导体流出,从另一导体流回,电流均匀分布在横截面上, 设圆柱体的半径为 r_1 ,圆筒的内外半径分为 r_2 , r_3 。若场 点到轴线的距离为 /

求:从0到 ∞ 范围内各处磁感应强度的大小

解:





 $r < r_1$

$$\iint_{\mathbf{J}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 \frac{\pi r^2}{\pi r_1^2} I$$

$$B = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi r^2}$$

 $r_1 < r < r_2$

$$\iint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 I$$





 $r_2 < r < r_3$

$$\iint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 \left[I - \frac{I\pi(r^2 - r_2^2)}{\pi(r_3^2 - r_2^2)} \right]$$

$$B = \frac{\mu_0 I(r_3^2 - r^2)}{2\pi (r_2^2 - r_2^2)r}$$

$$r > r_3$$

$$\iint \vec{B} \cdot d\vec{l} = I - I = 0$$
 $B = 0$

III.电磁感应小结

一、电磁感应定律

1、法拉第电磁感应定律

用法拉第电磁感应定律确定电动势方向,通常 遵循以下步骤:

- ①任意规定回路的绕行正方向;
- ②确定通过回路的磁通量的正负;
- ③确定磁通量的时间变化率的正负;
- 4最后确定感应电动势的正负。
- 2、楞次定律(是能量守恒定律的一种表现)

闭合的导线回路中所出现的感应电流,总是使它 自己所激发的磁场反抗任何引发电磁感应的原因。

二、动生电动势和感生电动势

1、动生电动势

动生电动势的非静电力场来源 洛伦兹力

一段任意形状的导线 \mathbb{L} 在磁场中运动时 $\mathbf{c} = \int_{\mathcal{C}} (\vec{v} imes \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

整个闭合导线回路L都在磁场中运动时: $\varepsilon = \iint_{\Gamma} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

>动生电动势的计算(两种方法)

①由法拉第定律求

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\,\Phi}{\mathrm{d}\,t}$$

如果回路不闭合,需加辅助线使其闭合。 ε 大小和方向可分别确定 .

1、均匀磁场,平动

例 1 已知: \vec{v} , \vec{B} , α ,L 求: ε

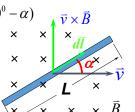
解:
$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

 $= vB\sin 90^{\circ}dl\cos(90^{\circ} - \alpha)$

 $= Bv \sin \alpha dl$

 $\varepsilon = \int Bv \sin \alpha \, dl$

 $= BvL\sin\alpha$



典型结论

 $\varepsilon = BvL\sin\alpha$

均匀磁场 闭合线圈平动



$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = 0$$

金属棒上总电动势为

 $v = \omega l$

转动,求棒中的动生电动势。 \mathbf{M} : 取线元 $d\vec{l}$, 方向沿O指向A

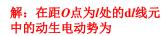
 $\varepsilon_{i} = -\int_{0}^{L} Bv \, dl = -\int_{0}^{L} B\omega l \, dl = -\frac{1}{2} B\omega L^{2}$

M 3 长为L的铜棒,在磁感强度为 \bar{B} 的均匀磁场中以 角速度 α 在与磁场方向垂直的平面内绕棒的一端 α 匀速

方向为 $A \rightarrow O$,即O点电势较高。

 $d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -vBdl$

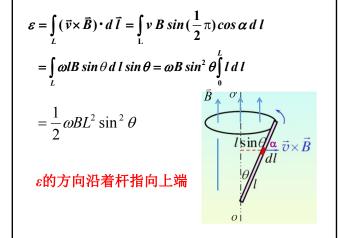
例 4长度为L的金属杆在均匀磁场 中绕平行于磁场方向的定轴OO' 转动,已知杆相对于均匀磁场 的方位角为 θ ,杆的角速度为 ω ,转动方向如图所示. 试求金属杆L在转动过程中产生的动生电动势的大小和方向。



$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$v = \omega l \sin \theta$$

$$d\varepsilon = \int_{L} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_{L} v B \sin(\frac{1}{2}\pi) \cos \alpha \, d\vec{l}$$



2、非均匀磁场

例5 一长直导线中通电流*I*,有一长为 *I* 的金属棒与导线垂直共面(左端相距为*a*)。当棒以速度 *v* 平行与长直导线匀速运动时,求棒产生的动生电动势。

解:
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

$$d\varepsilon_i = (\vec{v} \times B) \cdot d\vec{x} = -Bv dx$$

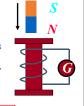
$$\varepsilon_i = -\int_a^{a+l} \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \frac{dx}{x}$$

$$= -\frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{a+l}{a}$$
 \vec{x}

三、感生电动势和涡旋电场

1、感生电动势

导体回路不动,由于磁场变化引起 穿过回路的磁通量变化,产生的感应电 动势叫感生电动势。

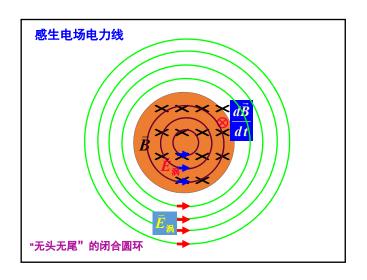


显然,产生感生电动势的非静电力一定不是洛 伦兹力。

产生感生电动势的非静电力是什么?

2、麦克斯韦假设

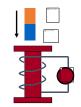
变化的磁场在其周围空间会激发出电场线为闭合 曲线的电场,称其为感生电场 \vec{E}_{ss} 或涡旋电场 \vec{E}_{ss}



三、感生电动势和涡旋电场

1、感生电动势

导体回路不动,由于磁场变化引起 穿过回路的磁通量变化,产生的感应电 动势叫感生电动势。

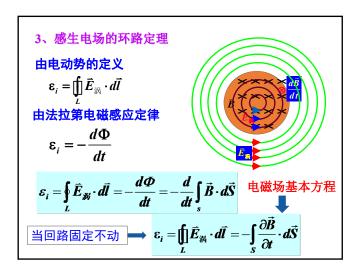


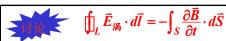
显然,产生感生电动势的非静电力一定不是洛 伦兹力。

产生感生电动势的非静电力是什么?

2、麦克斯韦假设

变化的磁场在其周围空间会激发出电场线为闭合 曲线的电场,称其为感生电场 或涡旋电场





- 1) 此式反映变化磁场和感生电场的相互关系, 即感生电场是由变化的磁场产生的。
- 2) S 是以闭合路径 L 为边界的任一平面或曲面。



闭合路径 L的积分绕行与其所包围 面积S的法线正方向满足右手螺旋法

则。

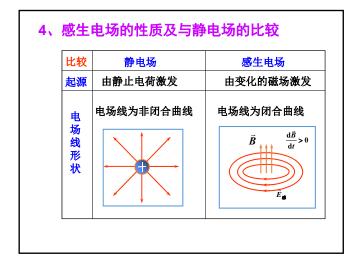
<u>∂</u>*B* 是曲面上的任一面元上磁感应强度的变化率

不是积分回路线元上的磁感应强度的变化率

- 3)这是电磁场基本方程之一。
- 4) 某一段细导线内的感生电动势

$$\varepsilon_i = \int_a^b \vec{E}_{\vec{\otimes}} \cdot d\vec{l}$$

	动生电动势	感生电动势
特点	磁场不变,闭合电路的整 体或局部在磁场中运动导 致回路中磁通量的变化	闭合回路的任何部分都不 动,空间磁场发生变化导 致回路中磁通量变化
原因	由于S的变化引起 回路中Φ变化	由于B的变化引起 回路中Φ变化
非静电力 的来源	非静电力就是洛仑兹力, 由洛仑兹力对运动电荷 作用而产生电动势	变化磁场在它周围空间激发 涡旋电场,非静电力就是感 生电场力,由感生电场力对 电荷作功而产生电动势
结论	$ \epsilon_{i} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} $ 其方向由 $\vec{v} \times \vec{B}$ 决定	$ \epsilon_i = \int \bar{E}_{ij} \bullet d\bar{l} = -\iint_S \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} \bullet d\bar{S} $ 其方向由 \bar{E}_{ij} 沿 $d\bar{l}$ 的积分方向决定



比较	静电场	感生电场
性质	有源: $\oint_{s} \vec{E}_{\oplus} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\rm ph}$	无源: $\oint_{s} \vec{E}_{\vec{s}} \cdot d\vec{S} = 0$
	保守: $\oint_L \vec{E}_{\#} \cdot d\vec{l} = 0$	非保守 (涡旋): $\oint_L \vec{E}_{ss} \cdot d\vec{I} = -\int_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$
特点	不能脱离源电荷存在	可以脱离"源"在空间传播
对场中 电荷的 作用	$\vec{F}_{\#} = q \vec{E}_{\#}$	$\vec{F}_{8} = q\vec{E}_{8}$
相互 联系	序。作为产生ε。的非静电力,可以引起导体中电荷 堆积,从而建立起静电场.	$ \frac{dB}{dt} > 0 \times \overline{B} \times \times $ $ A \times E \times B $

5、感生电场的计算 $\iint_{L} \vec{E}_{ss} \cdot d\vec{l} = -\int_{s} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$

例 局限于半径 R 的圆柱形空间内分布有均匀磁场, 方向如图。磁场的变化率 $\partial B/\partial t > 0$

求: 1) 圆柱内、外的 \vec{E}_{ss} 分布。

解:r < R

$$\iint_{\vec{k}} \vec{E}_{i\vec{k}} \cdot d\vec{l} = -\int_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\iint_{I} E_{3A} dl \cos \theta = -\int_{S} \frac{\partial B}{\partial t} dS \cos \theta$$

讨论
$$E_{ij} = -\frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t}$$



负号表示 \bar{E}_{ss} 与 $\partial B/\partial t$ 反号

- (1) $|\vec{B}|$ ↓ Ŋ $\partial B/\partial t < 0 \rightarrow E_{\infty} > 0$ \bar{E}_{x} 与 L 积分方向切向同向
- (2) $|\vec{B}| \uparrow \mathbb{N}$ $\partial B/\partial t > 0 \rightarrow E_{\infty} < 0$ \bar{E}_{ss} 与 L 积分方向切向相反

只要有变化磁场,整个空间就存在感生电场.

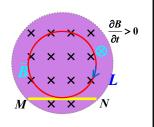
将长为L的金属棒MN放在具有匀强磁场分布的 一圆柱形区域内, 试求金属棒MN 中的感生电动 势,并判断电势高低。

解:由前题的结果可知

$$r < R \qquad E_{\%} = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

$$r < R \qquad E_{\text{R}} = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

$$r > R \qquad E_{\text{R}} = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$



三、自感应和互感应

1、自感应

自感系数或自感

$$L = \frac{\psi}{I}$$

自感电动势:

$$\varepsilon_L = -L \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

2、互感应

互感系数简称为互感 $M = \frac{\psi_{21}}{I_1} = \frac{\psi_{12}}{I_2}$ 互感电动垫・

互感电动势:

$$\varepsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}$$

$$\varepsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt} \qquad \varepsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt}$$

四、磁场的能量

$$W_{\rm m} = \frac{1}{2} LI^2$$

$$w_{\rm m} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

1、自感磁能
$$W_{\rm m} = \frac{1}{2} L I^{\, 2}$$
 2、磁场能量密度
$$w_{\rm m} = \frac{B^2}{2 \mu_0}$$
 3、磁场能量
$$W_{\rm m} = \int_V w_{\rm m} {\rm d}V = \int_V \frac{B^2}{2 \mu_0} {\rm d}V$$

类比

电容器储能

$$\frac{1}{2}CU^2$$

电场能量密度

$$\boldsymbol{w_e} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon_0} \boldsymbol{E}^2$$

$$\boldsymbol{W}_{e} = \int_{V} \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon}_{0} \boldsymbol{E}^{2} d\boldsymbol{V}$$

电感器储能

$$\frac{1}{2}LI^2$$

磁场能量密度

$$\boldsymbol{w}_{e} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon}_{0} \boldsymbol{E}^{2} \qquad \qquad \boldsymbol{w}_{m} = \frac{1}{2} \frac{\boldsymbol{B}^{2}}{\boldsymbol{\mu}_{0}}$$

$$W_m = \int_V \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} dV$$

自己继续总结:

在各种场源带电体情况下 E~r图 u~r图 的特点、导体问题、电容问题、磁力问题、 电磁感应等等